

LNA2903L

GaAs Infrared Light Emitting Diode

For optical control systems

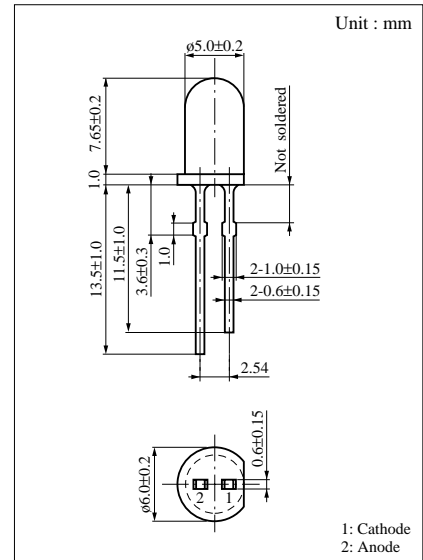
■ Features

- High-power output, high-efficiency : $I_e = 9 \text{ mW/sr}$ (min.)
- Emitted light spectrum suited for silicon photodetectors
- Good radiant power output linearity with respect to input current
- Wide directivity : $\theta = 20 \text{ deg.}$ (typ.)
- Transparent epoxy resin package

■ Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

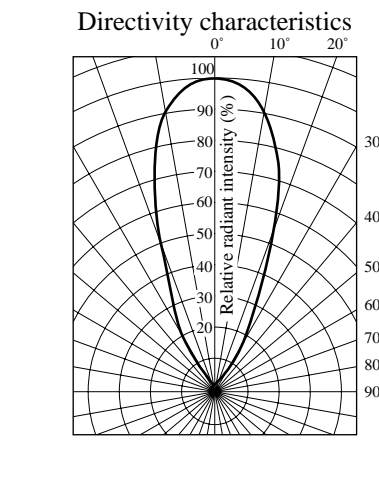
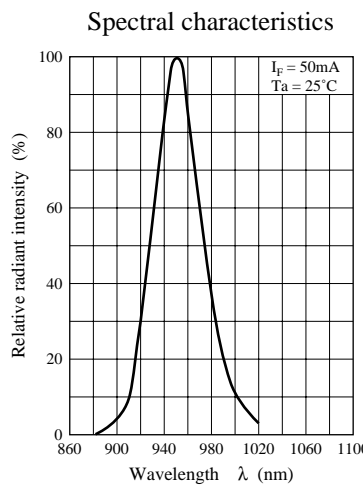
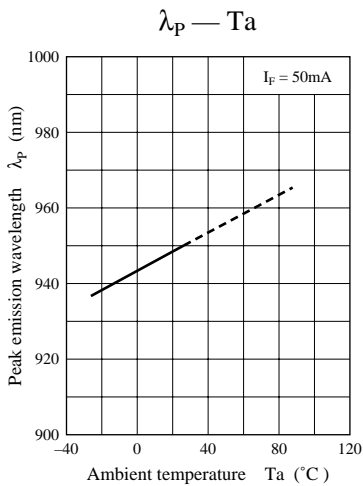
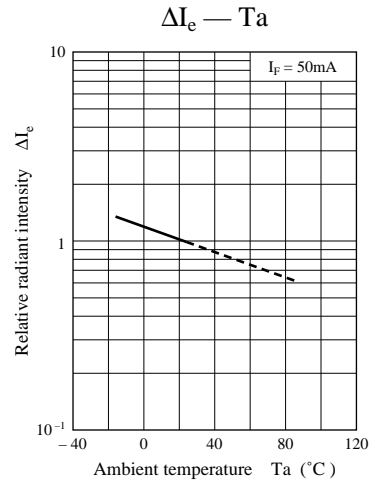
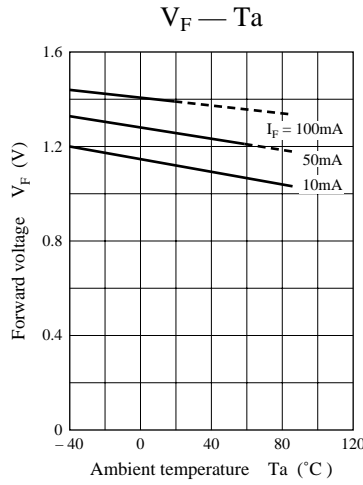
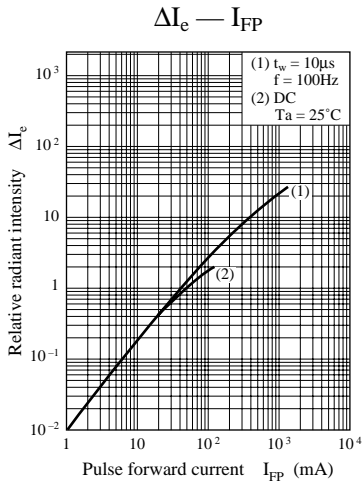
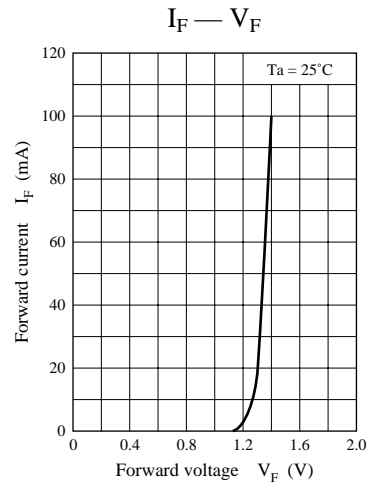
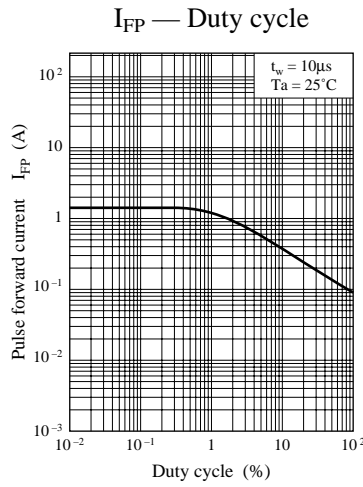
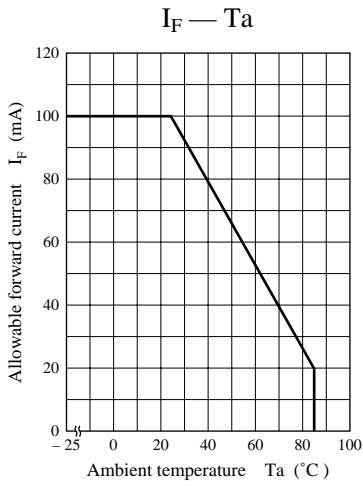
| Parameter | Symbol | Rated | Unit |
|-------------------------------|------------|-------------|------------------|
| Power dissipation | P_D | 160 | mW |
| Forward current (DC) | I_F | 100 | mA |
| Pulse forward current | I_{FP}^* | 1.5 | A |
| Reverse voltage (DC) | V_R | 3 | V |
| Operating ambient temperature | T_{opr} | -25 to +85 | $^\circ\text{C}$ |
| Storage temperature | T_{stg} | -40 to +100 | $^\circ\text{C}$ |

* $f = 100 \text{ Hz}$, Duty cycle = 0.1 %

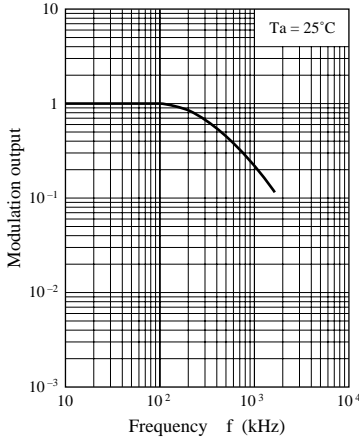


■ Electro-Optical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

| Parameter | Symbol | Conditions | min | typ | max | Unit |
|-----------------------------|-----------------|---|-----|-----|-----|---------------|
| Radiant intensity at center | I_e | $I_F = 50\text{mA}$ | 9 | | | mW/sr |
| Peak emission wavelength | λ_p | $I_F = 50\text{mA}$ | | 950 | | nm |
| Spectral half band width | $\Delta\lambda$ | $I_F = 50\text{mA}$ | | 50 | | nm |
| Forward voltage (DC) | V_F | $I_F = 100\text{mA}$ | | 1.4 | 1.6 | V |
| Reverse current (DC) | I_R | $V_R = 3\text{V}$ | | | 10 | μA |
| Capacitance between pins | C_t | $V_R = 0\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$ | | 35 | | pF |
| Half-power angle | θ | The angle in which radiant intensity is 50% | | 25 | | deg. |



Frequency characteristics



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>